

項次	專利名稱	國別	申請號	證書號	申請日	取證日	專利有效期限 (起)	專利有效期限 (迄)
1	Self-aligned unsymmetrical gate (SAUG) FinFET and methods of forming the same	美國	16/374,475	US 10,971,629 B2	2019-04-03	2021-04-06	2019-04-03	2039-04-03
2	衰減器	日本	JP2026-000015	JP3254985U	2026-01-05	2026-02-26	2026-02-26	2036-01-05
3	金氧半閘堆疊結構的製造方法	台灣	103123414	I531071	2014-07-08	2016-04-21	2016-04-21	2034-07-07
4	METHOD FOR MANUFACTURING GATE STACK STRUCTURE IN INSTA-METAL-OXIDE-SEMICONDUCTOR FIELD-EFFECT-TRANSISTOR	美國	14/619,594	US 9,299,796 B2	2015-02-11	2016-03-29	2016-03-29	2035-02-11